## 2023 春 電子學(二) 國立陽明交通大學電機工程學系

## 繪製MOSFET電流-電壓曲線加分題

說明:請以程式語言(c++/c/python/matlab/java/.....等任何自己熟悉之程式語言擇一即可),依題意完成程式,並於期限前將程式碼寄給助教確認,助教檢查完程式會寄信回覆可以驗收的時間,驗收確定程式可以正確執行,則獲得分數。請盡早提交程式,以確保能找到雙方的空檔,超過期限未能完成驗收,一律不計入。用手繪製不計分。

期限:2023/03/27 電子學上課前完成驗收。

## 題目:

參考課本第五章MOSFET電流公式以及第七章講義第八頁提供的製程節點 參數表,考慮通道調變效應,畫出:

- 1. N型與P型MOSFET的 $I_D$ - $V_G$ 關係圖: $|V_D| = V_{DD}/100和V_{DD}$ , $|V_G|$ 的範圍取 $0\sim V_{DD}$ 。
- 2. N型與P型MOSFET的 $I_D$ - $V_D$ 圖: $|V_D|$ 的範圍取 $0 \sim V_{DD}$ , $|V_G|$ 在 $0 \sim V_{DD}$  的區間取等間距的五個值。

請注意:圖上須標示單位。製程節點須由助教指定,經助教驗收確認無誤至多加期中考成績5分。有問題可以提問。